

Procedeu de recristalizare a microfirului pe bază de bismut în izolație de sticlă, care constă în mișcarea microfirului printr-un condensator format din două plăci de cupru, care generează un câmp electric puternic, încălzirea microfirului cu un fascicul laser până la temperatura de topire a miezului cu formarea unei zone de topire înguste, care în direcția de mișcare a microfirului în interiorul condensatorului este imediat recristalizată de un flux de aer, cu direcția axei cristalografice C3 a microfirului în direcția câmpului electric.